



(51) МПК

H01L 23/525 (2006.01)

H01L 31/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

## (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (титульный лист)

(21), (22) За вка: 2008129722/22, 18.07.2008

(24) Дата начала отсчета срока действи патента:  
18.07.2008

(45) Опубликовано: 27.02.2009 Бюл. № 6

Документ находится в Патентном отделе

**ОКБ АСТРОН**140081, Московская область, г.Лыткарино,  
ул.Парковая, д.1(54) БОЛОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРИЕМНИК, УЧИТЫВАЮЩИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

## (57) Формула полезной модели

1. Болومترический приемник, включающий полупроводниковую подложку, содержащую микросхему преобразовани фотосигнала в выходной электрический сигнал, снабженную выходными контактами, и диэлектрическое покрытие, между которыми помещены первый защитный диэлектрический слой, нанесенный на названную полупроводниковую подложку, в котором выполнена перва пара контактных окон, расположенных напротив выходных контактов названной микросхемы, теплоизолирующий диэлектрический слой, выполненный в форме мостика, концы которого опираютс на первый защитный диэлектрический слой, а средн часть приподн та над ним с зазором, первый регистрирующий ИК-излучение слой, нанесенный на названный теплоизолирующий диэлектрический слой таким образом, что его концы вход т в первую пару контактных окон первого защитного диэлектрического сло , отличающийс тем, что в первом защитном диэлектрическом слое выполнена втора пара контактных окон, расположенных напротив выходных контактов названной микросхемы, а между названными полупроводниковой подложкой и диэлектрическим покрытием расположен второй защитный диэлектрический слой, выполненный в форме мостика, концы которого опираютс на первый защитный диэлектрический слой, а средн часть приподн та над ним с зазором, на который нанесен второй регистрирующий ИК-излучение слой таким образом, что его концы вход т во вторую пару контактных окон первого защитного диэлектрического сло , при этом на участок диэлектрического покрыти , расположенный над вторым регистрирующим ИК-излучение слоем, нанесено светоотражающее покрытие.

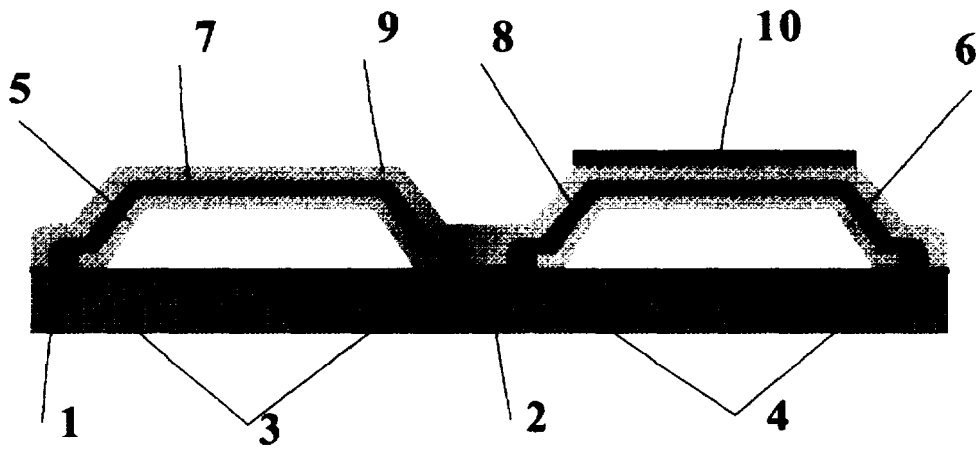
2. Приемник по п.1, отличающийс тем, что он помещен в вакуумную камеру.

3. Приемник по п.1, отличающийс тем, что первый и второй регистрирующие ИК-излучение слои имеют идентичные геометрию и материал.

4. Приемник по п.1, отличающийс тем, что микросхема преобразовани фотосигнала в выходной электрический сигнал вл етс мостовой схемой.

RU 80 995 U1

RU 80 995 U1



RU 80995 U1

RU 80995 U1